


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Актуализировано:
на заседании кафедры
протокол №8 от «22»июня 2017 г.

Согласовано:
Председатель УМК физико-технического
института

Зав. кафедрой  /Р.З. Бахтизин

 /М.Х. Балапанов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

дисциплина _____ Современные методы исследования твердых тел _____
(наименование дисциплины)

_____ вариативная _____

(Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору))

программа бакалавриата


Направление подготовки
03.03.03 Радиоп физика

(наименование ООП ВПО направления подготовки или специальности с указанием кода)

Профиль(и) подготовки
Цифровые технологии обработки информации

Квалификация
_____ бакалавр _____

(указывается квалификация)

| | |
|---|--|
| Разработчик (составитель) д.ф.-м.н., проф. (должность, ученая степень, ученое звание) |  _____/ Бахтизин Р.З. (подпись, Фамилия И.О.) |
|---|--|

Для приема: 2016 г.

Уфа 2017 г.

Составитель / составители: Бахтизин Р.З., д.ф.-м.н., проф. кафедры физической электроники и нанопластики БашГУ.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры протокол от «22» июня 2017 г. № 8

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры физической электроники и нанопластики: актуализированы обязательная и дополнительная литература, рейтинг-план; протокол № 6 от «07» июня 2018 г.

Заведующий кафедрой



_____ / Р.З. Бахтизин /

Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)
4. Фонд оценочных средств по дисциплине
 - 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
 - 4.3. *Рейтинг-план дисциплины (при необходимости)*
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(с ориентацией на карты компетенций)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки:

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (основной этап формирования данной компетенции)

ПК-1 Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ПК-2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

Табл. 1

| Результаты обучения | | Формируемая компетенция (с указанием кода) | Примечание |
|---------------------------------------|---|--|------------|
| Знания | 1. Знать основные материалы, используемые в твердотельной электронике, технологии их получения и области применения | ОПК-1 | |
| | 2. Знать основные методы измерения работы выхода и других характеристик, используемых в твердотельной электронике материалов | ПК-1 | |
| | 3. Знать приборную базу и конструкции основных устройств, используемых для определения базовых характеристик п/п материалов | ПК-2 | |
| Умения | 1. Использовать знания, полученные при изучении этого курса, для последующего изучения курсов физики конденсированного состояния, наноэлектроники и нанопластики | ОПК-1 | |
| | 2. Разрабатывать технологические карты получения новых полупроводниковых материалов и пленочных систем | ПК-1 | |
| | 3. Использовать правильную терминологию, определения/обозначения/единицы измерения величин для описания характеристик твердотельных материалов и областей их применения | ПК-2 | |
| Владения (навыки / опыт деятельности) | 1. Владеть экспериментальными навыками по определению свойств материалов, в том числе методами электронной и фотоэлектронной спектроскопии | ПК-1 | |
| | 2. Владеть методиками решения задач по определению базовых характеристик тонких пленок металлов и полупроводников | ПК-2 | |

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Дисциплина “Современные методы исследования твердых тел” является базовой и входит в раздел «Б1.Б.12.» (профессиональный цикл) ФГОС по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика». Знания, полученные в результате освоения курса “Современные методы исследования твердых тел” позволяют создавать электронные приборы и вырабатывать методы исследования новых материалов, необходимых для разработки новых электронных приборов и устройств. Поэтому, изучение дисциплины является одним из необходимых элементов подготовки специалистов по данному направлению.

Цель курса “Современные методы исследования твердых тел”- теоретическая и практическая подготовка студентов, которая должна обеспечивать понимание работы современных электронных приборов, методов измерения физических величин, принципов построения, работы и путей совершенствования современных цифровых систем измерений.

2.2. Дисциплина “Современные методы исследования твердых тел” одна из основных дисциплин профиля, так как без знания физико-химических характеристик материалов и протекающих в них физических процессов невозможны сознательные и эффективные подходы к разработке изделий электронной техники и к организации технологических процессов. По предмету и методам своих исследований данный курс тесно связан с физикой конденсированного состояния и физическими основами электроники и способствует формированию у будущих специалистов принципов физического и инженерного подхода к оценке возможностей использования материалов в конкретных элементах и устройствах электронной техники. Задачи курса - закрепление знаний, фундаментальных понятий, положений и теорем курсов «Основы радиоэлектроники», «Теория электрических цепей», «Квантовой механики» и курса «ФКС» и формирование умений применять эти знания на практике для разработки новых измерительных приборов, методов диагностики поверхности твердых тел, а также обеспечение понимания студентами связи между теоретическими моделями и особенностями их практической реализации.

2.3. Место дисциплины в учебном процессе. Согласно государственному образовательному стандарту ФГОС курс “Современные методы исследования твердых тел” является общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающимися по направлению 03.03.03 «Радиофизика» и изучается студентами в 5-м семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Согласно ОП подготовки бакалавра по направления 03.03.03_ «Радиофизика», профиль «Радиофизика и электроника» и рабочему учебному плану (РУП) по дисциплине «Современные методы исследования твердых тел» отводится:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| общий объем часов по дисциплине | 72 (всего 2 ЗЕТ); |
| в том числе аудиторных часов | 54; |
| контактных часов | 56. |

Разбиение общего числа часов по видам учебных занятий с указанием их объемов приведено в таблице 2

Табл. 2

| Виды учебной работы | Общий объем по РУП_102_ |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Аудиторные занятия | 54 |
| Лекции | 0 |
| Лабораторные занятия | 18 |
| Семинарские занятия | 36 |
| Самостоятельная работа студентов | 16 |
| Контроль самостоятельной работы (КСР) | 2 |
| Виды контроля | Зачет |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины _“Современные методы исследования твердых тел”_ на __7__ семестр

(наименование дисциплины)

Рабочую программу осуществляют:

Зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) _2_

Учебных часов:
 лекций 0

Лекции: профессор кафедры физической электроники и нанофизики, д.ф.-м.н. Бахтизин Р.З.

семинарских 36 (7 семестр)

(должность, уч. степень, ф.и.о.)

лабораторных 18 (7 семестр)

самостоятельная работа студентов 34
 КСР 6 (3 семестр)

В том числе контактных часов 56

Лабораторные и практические занятия: доцент кафедры физической электроники и нанофизики, к.ф.-м.н. Шарипов Т.И.

(должность, уч. степень, ф.и.о.)

5. Содержание курса

| № п.п. | Тема и содержание | Форма изучения материала | Кол-во часов | Межпредметные связи | Основная и дополнительная литература | Задания по самостоятельной работе студентов | Количество часов | Форма контроля самостоятельной работы |
|--------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|---|------------------|--|
| 1 | Введение. Исторический очерк развития электронной микроскопии и физики микрообъектов. | Семинар | 2 | Физическая электроника | Л. 1- Л. 13 | По списку заданий | 2 | |
| 2 | Тема 1. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) и спектроскопия (СТС). Топографайнер Р.Янга. Основная идея СТМ и ее реализации. Роль зондирующего острия. СТМ-изображения поверхности Au(110) и графита. Поверхность Si(111)-7×7 и модель Такаянаги. Димерная модель поверхности Si(100)-2×1. Проблемы сканирующей туннельной спектроскопии.. | Семинар Лабораторные занятия Самостоятельная работа | 6 0 4 | Информатика и вычислительная техника | Л. 1 - Л. 2 Л. 3 Л. 14 | Индивидуальные задания | 6 | Коллоквиум |
| 3 | Тема 2. Атомная структура поверхностей с адсорбатами. Поверхностные фазы в субмонослойных системах адсорбат/подложка; состав поверхностных фаз; фазовая диаграмма. Семейство структур $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ и 3×1 на Si(111). Фазы 2×1 , 1×1 и 3×1 в системе H/Si(100). | Лабораторные занятия Самостоятельная работа | 8 4 | Физическая электроника | Л. 1 Л. 2 Л. 3 | Индивидуальные задания | 8 | Текущие проверки конспектов изучения литературы, |
| 4 | Тема 3. Применение СТМ и СЗМ в нанотехнологии и нанoeлектронике. Атомная сборка и самоорганизующиеся системы. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) и ее применение в нанотехнологии. СТМ контроль атомных структур на поверхностях GaAs (001) и GaN(0001), выращенных методами МЛЭ. Создание и исследование квантовых наноструктур. | Лекции Лабораторные занятия Самостоятельная работа | 8 2 | Физика твердого тела и твердотельная электроника | Л. 1 Л. 3 Л. 13 | | 6 | Коллоквиум |
| 5 | Тема 4. Фуллерены и углеродные нанотрубки. Основные свойства фуллеренов и нанотрубок. Пленки фуллеренов на поверхности металлов. Взаимодействие фуллеренов с поверхностями полупроводников. Производные фуллеренов и их применение, фторфуллерены. Углеродные нанотрубки и их применение в нанoeлектронике. Графен и его свойства | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Тема 5. Нитриды алюминия, галлия, индия и их сплавы – новые материалы для оптоэлектроники. | | | | | | | |
| 7 | Тема 6. СТМ и СТС исследование элементарных физико-химических процессов на поверхности твердых тел. Молекулярная наноэлектроника. | | | | | | | |
| 8 | Топологические изоляторы. | | | | | | | |

Список лабораторных работ по курсу "Современные методы исследования твердых тел"

1. Проведение структурного анализа поверхности твердых тел при различных масштабах.
2. Изучение принципов сканирования поверхности твердых тел в режимах СТМ и АСМ.
3. Моделирование кристаллических решеток с использованием программы Carline Crystallography 3.1.
4. Изучение основ проведения векторных литографических операций на двухкоординатных аналоговых устройствах отображения.
5. Изучение основ оптического метода сканирования изображений.

6. Литература

1. Основная

- [1]. К. Оура, В.Г. Лифшиц, А.А. Саранин, А.В. Зотов, М. Катаяма. *Введение в физику поверхности*. М.: Наука.-2006. 490 с.
- [2]. Р.З. Бахтизин и Р.Р. Галлямов. *Физические основы сканирующей зондовой микроскопии*. Уфа: БашГУ. 2004.
- [3]. В.Л. Миронов. *Основы сканирующей зондовой микроскопии*. Нижний Новгород: ИФМ РАН. 2004.

2. Дополнительная

- [4]. Р.З. Бахтизин, Ч. Пак, Т. Хашицуме и Т. Сакурай. *ЖЭТФ*. 1995. Т. **108**. Вып. 5. С. 977. *ЖТФ*. 1994. Т. **64**. Вып. 8. С. 113.
- [5]. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме, Д.-Щ. Вонг и Т. Сакурай. *УФН*. 1997. Т. **167**. №3. С. 289.
- [6]. Р.З. Бахтизин, К.-К. Щуе, Т. Хашицуме и Т. Сакурай. *УФН*. 1997. Т. **167**. №11. С. 1227.
- [7]. Р.З. Бахтизин. Голубые диоды. *Соросовский Образовательный Журнал*. 2001. № 3. С. 75.
- [8]. Р.З. Бахтизин, К.-К. Щуе, Ю. Хасегава, Т. Сакурай. *ЖЭТФ*. 2000. Т. **113**. Вып. 11. С. 1153.
- [9]. Р.З. Бахтизин, Ч.-Ж. Щуе, Ч.-К. Щуе, К.-Х. Ву, Т. Сакурай. *УФН*. 2004. Т. **174**. №4. С.383.
- [10]. А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. *УФН*. 1995. Т.**165**. №9. С. 977. *УФН*. 1993. Т.**163**. №1. С. 33. *УФН*. 2002. Т.**172**. №4. С. 401.
- [11]. Р.З. Бахтизин. Сканирующая туннельная микроскопия – новый метод изучения поверхности твердых тел. *Соросовский Образовательный Журнал*. 2000. № 8.
- [12]. L.E. Murr. *Electron and Ion Microscopy and Microanalysis. Principles and applications*. 2nd Edition. NY-Basel-Hong Kong: 1991.
- [13]. S. Nakamura, G .Fasol. *The Blue Laser Diodes (GaN Based Light Emitters and Lasers)*.Berlin-Heidelberg: Springer. 1997. 175p.
- [14]. Ph. Avouris and R. Wolkow. *Physical Review B*. 1989. V. **39**. №8. P. 5091.

7. Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают два теоретических вопроса и три задачи.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, если он свободно ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, четко представляет назначение и выполняемые функции радиотехнических компонентов, умеет реализовывать алгоритмы цифровой обработки сигналов на функциональном и программном уровне, четко представляет источники возникновения погрешностей и методы их расчета.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если он свободно ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, четко представляет назначение и выполняемые функции радиотехнических компонентов, умеет реализовывать алгоритмы цифровой обработки сигналов на функциональном и программном уровне, четко представляет источники возникновения погрешностей и методы их расчета, однако, для полного ответа на отдельные поставленные вопросы требуются дополнительные пояснения и уточнения со стороны преподавателя.;

оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если он ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, в целом представляет назначение и выполняемые функции радиотехнических компонентов, умеет реализовывать алгоритмы цифровой обработки сигналов на функциональном и программном уровне, имеет общее представление об источниках возникновения погрешностей и методах их расчета, однако, для полного ответа на отдельные поставленные вопросы требуются существенные пояснения и уточнения со стороны преподавателя.;

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если он не ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, не представляет себе назначение и выполняемые функции радиотехнических компонентов, затрудняется в реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов на функциональном и программном уровне, не имеет общих представлений об источниках возникновения погрешностей и методах их расчета.

8. Методические рекомендации студентам по организации изучения дисциплины

1. Приступая к изучению предмета, необходимо ознакомиться с учебной программой курса «Современные проблемы физической электроники».
 2. Каждый раздел курса «Современные проблемы физической электроники» должен быть в процессе изучения кратко законспектирован.
 3. После проработки каждого раздела курса «Современные проблемы физической электроники» по конспектам лекций и по рекомендованным учебным пособиям необходимо ответить на контрольные вопросы, помещенные в конце каждой темы учебного пособия.
 4. Преподаватель проводит в конце каждого семестра собеседование со студентами по конспектам лекций и других записей.
 5. Отчеты по лабораторным работам оформляются на компьютере индивидуально каждым студентом. Все графические и численные результаты формируются в виде цифровых копий экрана. Полученные на лабораторных занятиях результаты переписываются на индивидуальные съемные носители информации.
 6. По каждому заданию лабораторной работы в отчете должны быть сформулированы аргументированные выводы. Не допускается ограничиваться выводами не по существу. Например, не следует использовать фразы со словами «Выполнили ...», «Изучили ...», «Освоили ...», «Узнали ...» и т.п.
 7. Отчет по каждой лабораторной работе публично защищается студентом. Во время защиты студент должен продемонстрировать понимание всех методических подходов, связанных с выполнением данной лабораторной работы. Полученные численные и графические результаты должны быть кратко описаны в тексте отчета и в выводах.
 8. При защите каждой лабораторной работы студент должен показать следующее:
 - Степень усвоения теоретического материала;
 - Практические навыки выполнения компьютерных расчетов по изученным теоретическим зависимостям;
 - Умение расчетов погрешностей измерений, связанные с цифровой обработкой измерительной информации и особенностями выбранных систем управления;
 - Объем и полноту изучения рекомендованных литературных источников.
-